

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD19531Q5A
fabbricante	Macraigor Systems LLC
Descrizione	MOSFET N-CH 100V 100A 8SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	4962 pcs Stock
Tensione - Prova	3870pF @ 50V
Tensione - Ripartizione	8-VSON (5x6)
Vgs (th) (max) a Id	6.4 mOhm @ 16A, 10V
Vgs (Max)	6V, 10V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	NexFET™
Stato RoHS	Digi-Reel®
Rds On (max) a Id, Vgs	100A (Tc)
Polarizzazione	8-PowerTDFN
Altri nomi	296-41232-6
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	20 Weeks
codice articolo del costruttore	CSD19531Q5A
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	48nC @ 10V
Tipo IGBT	±20V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	3.3V @ 250µA
Caratteristica FET	N-Channel
Descrizione espansione	N-Channel 100V 100A (Tc) 3.3W (Ta), 125W (Tc)
Tensione drain-source (Vdss)	-
Descrizione	MOSFET N-CH 100V 100A 8SON
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	100V
rapporto di capacità	3.3W (Ta), 125W (Tc)

 CSD19531Q5AT N/A MOSFET N-CH 100V 100A 8SON	 CSD19531Q5A IC TI TI VSON-8	 CSD19531 TI CSD19531 TI	 CSD19531Q5A N/A MOSFET N-CH 100V 100A 8SON
 CSD19532KTTT N/A MOSFET N-CH 100V TO-263-3	 CSD19506KTTT N/A IC MOSFET N-CH 80V TO-220	 CSD19532KTT N/A MOSFET N-CH 100V 200A DDPAK-3	 CSD19531KCS IC TI TI TO220

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited